Labor für Grundlagen Elektrotechnik Elektronik Labor Raum 505 haw-hamburg.de/ti-ie/labore/grundlagen-elektrotechnik

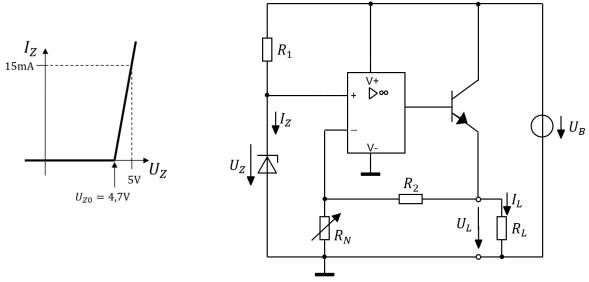


Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

| Seite 1/1 Version 1.1, 2.1.2021 Hasselbring, Lange | | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hambura University of Applied Sciences |
|--|-----------------|--|
| Studiengruppe: | Eingegangen am: | Protokollführer/in: |
| 5 | | |
| | | |
| Übungstag: | | Weitere Übungsteilnehmer: |
| 5 5 | | · · |
| | | |
| Dozent: | | |
| | | |
| | | |

Spannungsregler - theoretische Berechnung

Die folgend dargestellte Schaltung dient zur Herstellung einer konstanten Lastspannung von $U_L = 10 \, \text{V}$. Der Operationsverstärker kann als ideal angenommen werden. Die Basis-Emitterspannung des Transistors beträgt 0,6 V und seine Stromverstärkung 200. Für die Z-Diode gelte die gezeigte Kennlinie. Als weitere Werte sind $R_1=2.2\,\mathrm{k}\Omega$, $R_2=100\,\mathrm{k}\Omega$ und $U_B=20\,\mathrm{V}$ vorgegeben. Für den Lastwiderstand kann zunächst $R_L = \infty$ (offener Ausgang) angenommen werden.



- a) Kann am Eingang des Operationsverstärkers ein virtueller Kurzschluss angenommen werden? [ja] Begründen Sie Ihre Antwort.
- b) Wie groß ist der differentielle Widerstand r_Z der Z-Diode im Durchlassbereich? [$r_Z = 20 \Omega$]
- c) Berechnen Sie die Spannung U_Z über der Z-Diode. [$U_Z = 4,838 \text{ V}$]
- d) Welchen Widerstandswert R_N muss man einstellen, um die angestrebte Ausgangsspannung von $U_L = 10 \,\mathrm{V}$ zu erhalten? [$R_N = 93,717 \,\mathrm{k}\Omega$]
- e) Wie groß ist die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers in diesem Fall? [Ergebnis: 10,6 V]
- f) Geben Sie den funktionalen Zusammenhang $U_L = f(U_B, U_{Z0}, R_1, r_Z, R_N, R_f)$ allgemein an, d. h. die Lastspannung als Funktion der in der Klammer angegebenen Größen (ohne Einsetzen von Zahlenwerten). [$U_L = \left(U_{Z0} + r_Z \cdot \frac{U_B - U_{Z0}}{R_1 + r_Z}\right) \cdot \frac{R_N + R_2}{R_N}$ oder alternativ $U_L = \left(U_B - R_1 \cdot \frac{U_B - U_{Z0}}{R_1 + r_Z}\right) \cdot \frac{R_N + R_2}{R_N}$]
- g) Geben Sie die Ableitung dU_L/dU_B an. Um wieviel Millivolt ändert sich die Lastspannung U_L , wenn die Betriebsspannung U_B um 1 V variiert wird? [$\frac{dU_L}{dU_R}$ = 18,6 mV/V]
- h) R_L werde nun reduziert, so dass ein Laststrom I_L fließt. Welcher minimale Wert für R_L ist noch zulässig, wenn die an der Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors erzeugte Verlustleistung maximal $P_{CE,max} = 1 \text{ W betragen darf? } [R_{L,min} = 100 \,\Omega]$

Tipp: Nehmen Sie für eine einfachere Rechnung an, dass erstens der Emitterstrom des Transistors gleich dem Kollektorstrom ist und zweitens der Querstrom durch R2 gegenüber dem Laststrom vernachlässigt werden kann. Warum sind diese beiden Annahmen plausibel?